

s 2020 0049

Invenția se referă la tehnica și tehnologia semiconductorilor oxizi, în particular la procedee de obținere a senzorilor de *n*-butanol pe baza heterojoncțiunii ZnO-Al₂O₃.

Procedeul, conform invenției, include depunerea peliculei nanostructurate de ZnO pe un substrat din sticlă prin metoda sintezei chimice din soluții, depunerea pe pelicula de ZnO a peliculei de Al₂O₃ cu grosimea de 17...20 nm prin metoda vaporizării termice în vid a triizopropilatului de aluminiu (Al(C₃H₇O)₃) la temperatura substratului de 450°C, depunerea pe pelicula de Al₂O₃ a contactelor ohmice din Au-Cr în formă de meandru, tratarea fonică rapidă a structurii obținute la temperatura de 650°C timp de 30 s.

Revendicări: 1

Figuri: 3